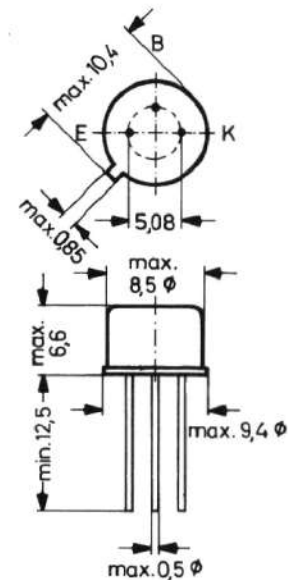


**NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistor  
für Video-Endstufen**

Metallgehäuse JEDEC TO-39  
5 C 3 nach DIN 41 873  
Gewicht ca. 1 g  
Kollektor mit Gehäuse verbunden  
Maße in mm

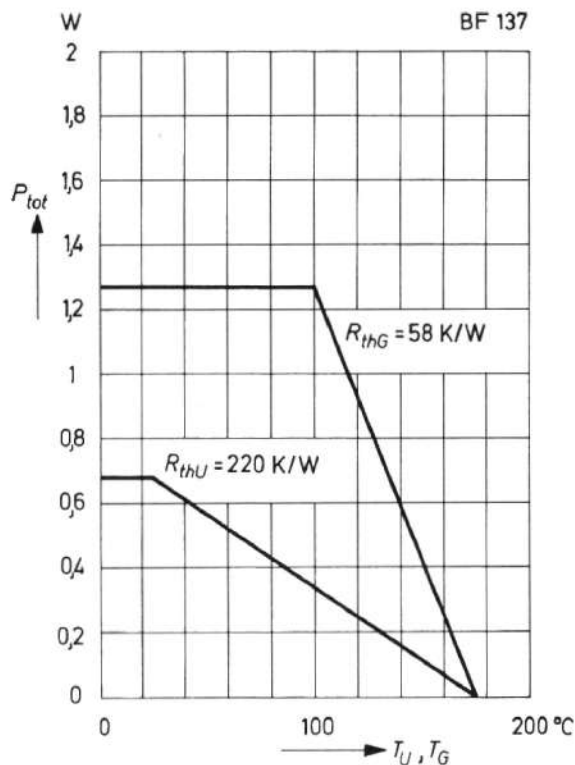

**Grenzwerte**

|                                                 |           |                                |                  |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| Kollektor-Basis-Spannung                        | $U_{CB0}$ | 160                            | V                |
| Kollektor-Emitter-Spannung                      | $U_{CE0}$ | 160                            | V                |
| Emitter-Basis-Spannung                          | $U_{EB0}$ | 5                              | V                |
| Kollektorstrom                                  | $I_C$     | 100                            | mA               |
| Verlustleistung<br>bei $T_U = 25^\circ\text{C}$ | $P_{tot}$ | 680                            | mW               |
| bei $T_G = 100^\circ\text{C}$                   | $P_{tot}$ | 1,27                           | W                |
| Sperrschichttemperatur                          | $T_i$     | 175                            | $^\circ\text{C}$ |
| Lagerungstemperaturbereich                      | $T_S$     | $-55 \dots +175^\circ\text{C}$ |                  |

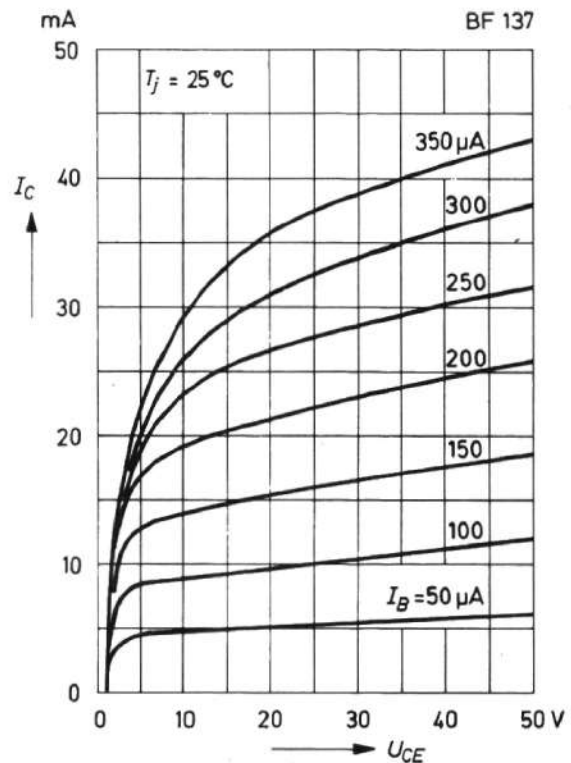
**Kennwerte bei  $T_i = 25^\circ\text{C}$** 

|                                                                                               |             |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|
| Kollektor-Basis-Stromverhältnis<br>bei $U_{CE} = 10\text{ V}$ , $I_C = 30\text{ mA}$          | $B$         | $> 25$  |     |
| Kollektor-Sättigungsspannung<br>bei $I_C = 30\text{ mA}$ , $I_B = 6\text{ mA}$                | $U_{CEsat}$ | $< 1$   | V   |
| Kollektorreststrom<br>bei $U_{CB} = 100\text{ V}$                                             | $I_{CB0}$   | $< 10$  | nA  |
| Emitterreststrom<br>bei $U_{EB} = 4\text{ V}$                                                 | $I_{EB0}$   | $< 50$  | nA  |
| Kollektor-Basis-Kapazität<br>bei $U_{CB} = 20\text{ V}$ , $f = 500\text{ kHz}$                | $C_{CB0}$   | 2       | pF  |
| Transitfrequenz<br>bei $U_{CE} = 10\text{ V}$ , $I_C = 20\text{ mA}$ ,<br>$f = 50\text{ MHz}$ | $f_T$       | 95      | MHz |
| Wärmewiderstand<br>Sperrschicht – umgebende Luft                                              | $R_{thU}$   | $< 220$ | K/W |
| Sperrschicht – Gehäuse                                                                        | $R_{thG}$   | $< 58$  | K/W |

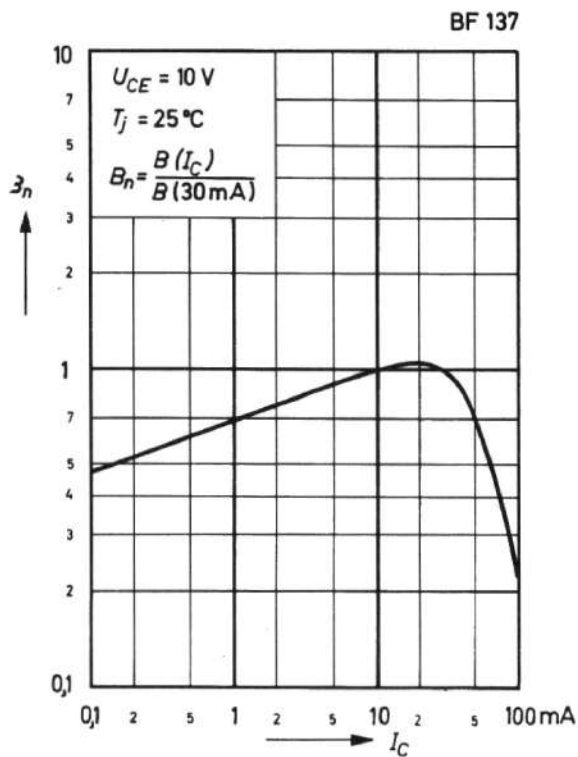
### zulässige Gesamtverlustleistung in Abhängigkeit von der Temperatur



### Ausgangskennlinien Emitterschaltung



### Kollektor-Basis-Stromverhältnis in Abhängigkeit vom Kollektorstrom



### Transitfrequenz in Abhängigkeit vom Kollektorstrom und von der Kollektor-Emitter-Spannung

